

Содержание

● Атомная структура и неэлектронные свойства полупроводников

Прокофьева Л.В., Пшенин-Северин Д.А., Константинов П.П., Шабалдин А.А.

Оптимальный состав твердого раствора $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-x}\text{Se}_x$ для n -ветви термогенератора 1009

Алиев Ф.Ф., Джафаров М.Б., Эминова В.И.

Термоэлектрическая добротность Ag_2Se с избытком Ag и Se 1013

● Электронные и оптические свойства полупроводников

Ермолович И.Б., Миленин В.В., Редько Р.А., Редько С.М.

Особенности рекомбинационных процессов в пленках CdTe , изготовленных при различных температурных режимах роста и последующих отжигах 1016

Казанский С.А., Уоррен мл. В.В., Рыскин А.И.

Спин-решеточная релаксация ядерных спинов ^{113}Cd и ^{19}F в кристаллической решетке полупроводниковых кристаллов CdF_2 с DX -центрами 1021

● Полупроводниковые структуры, границы раздела и поверхность

Беляев А.П., Рубец В.П., Тошходжаев Х.А.

Фотоэлектрические свойства сэндвич-структуры из пленок, синтезированных в резко неравновесных условиях 1029

● Низкоразмерные системы

Гаджиалиев М.М., Пирмагомедов З.Ш.

Температурная зависимость термоэдс диска Корбино из антимонида индия в квантующем магнитном поле 1032

Талочкин А.Б., Чистохин И.Б., Марков В.А.

Продольная фотопроводимость многослойных Ge/Si -структур с квантовыми точками Ge 1034

Горбатый И.Н.

Спиновый эффект Холла в полупроводниковых структурах с пространственно неоднородной спиновой релаксацией 1039

Гуринович Л.И., Лютич А.А., Ступак А.П., Прислопский С.Я., Русаков Е.К., Артемьев М.В., Гапоненко С.В., Демир Х.В.

Люминесценция квантово-размерных нанокристаллов и наностержней селенида кадмия во внешнем электрическом поле 1045

● Аморфные, стеклообразные, пористые, органические, микрокристаллические полупроводники, полупроводниковые композиты

Грузинцев А.Н., Емельченко Г.А., Масалов В.М.

Фотолюминесценция ZnO , инфильтрованного в трехмерный фотонный кристалл 1054

● Физика полупроводниковых приборов

Косяченко Л.А., Савчук А.И., Грушко Е.В.

Влияние толщины поглощающего слоя на эффективность солнечного элемента CdS/CdTe 1060

Горбатюк А.В., Серков Ф.Б.

Кооперативные эффекты при импульсном саморазогреве $p-i-n$ -диода 1065

Аверкиев Н.С., Слипченко С.О., Соколова З.Н., Тарасов И.С.

Диэлектрический волновод для среднего и дальнего инфракрасного излучения 1073

Новиков Ю.Н.

Энергонезависимая память, основанная на кремниевых нанокластерах 1078

Хрипунов Г.С., Черных Е.П., Ковтун Н.А., Белоногов Е.К.

Гибкие солнечные модули на основе сульфида и теллурида кадмия 1084

Иванов А.М., Мынбаева М.Г., Садохин А.В., Строган Н.Б., Лебедев А.А.

Транспорт заряда в структурах $4H\text{-SiC}$ -детекторов в условиях сильного электрического поля 1090

Данильченко В.Г., Корольков В.И., Солдатенков Ф.Ю.

Арсенидгаллиевые быстродействующие импульсные диоды на основе гетероструктур 1093

● Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Мизеров А.М., Жмерик В.Н., Кайбышев В.К., Комиссарова Т.А., Масалов С.А., Иванов С.В.

Особенности молекулярно-пучковой эпитаксии слоев $\text{GaN}(0001)$ и $\text{GaN}(000\bar{1})$ при использовании различных способов активации азота 1096

Стецюра С.В., Маляр И.В., Сердобинцев А.А., Климова С.А.

Влияние параметров узкозонных включений на тип и величину вторично-ионного фотоэффекта в гетерофазных фотопроводниках 1102

Торхов Н.А., Новиков В.А.

Фрактальная геометрия поверхностного потенциала электрохимически осажденных пленок платины и палладия 1109

**Чалдышев В.В., Яговкина М.А., Байдакова М.В.,
Преображенский В.В., Путьто М.А., Семягин Б.Р.**

Высокоразрешающие рентгеновские дифракционные исследования структур GaAs, выращенных при низкой температуре и периодически δ -легированных сурьмой и фосфором 1117

**Беляев А.Е., Болтовец Н.С., Иванов В.Н., Конакова Р.В., Кладько В.П., Кудрик Я.Я., Лебедев А.А.,
Миленин В.В., Шеремет В.Н.**

Свойства контактов GaN(SiC)–(Ti,Zr)B_x, подвергнутых быстрым термоотжигам 1125

Усмонов Ш.Н., Саидов А.С., Лейдерман А.Ю., Сапаров Д., Холиков К.Т.

Возможность получения пленок (GaSb)_{1-x}(Si₂)_x на кремниевых подложках методом жидкофазной эпитаксии . . . 1131

Середин П.В., Гордиенко Н.Н., Глотов А.В., Журбина И.А., Домашевская Э.П., Арсентьев И.Н., Шишков М.В.

Влияние буферного пористого слоя и легирования диспрозием на внутренние напряжения в гетероструктурах GaInP:Dy/pog-GaAs/GaAs(100) 1137

Моисеев К.Д., Пархоменко Я.А., Гущина Е.В., Анкудинов А.В., Михайлова М.П., Берт Н.А., Яковлев Ю.П.

Особенности эпитаксиального роста узкозонных квантовых точек InSb на подложке InAs 1142